Содержание

1		3
	1.1	Закон Кулона, напряжённость
	1.2	Поток, теорема Гаусса
	1.3	Циркуляция и дивергенция Е
	1.4	Энергия электрического поля
2		3
	2.1	Потенциал
	2.2	Уравнения Пуассона и Лапласа
	2.3	Проводимость, обобщённый закон Ома
3		4
	3.1	Био-Савар, виток с током
	3.2	Циркуляция магнитного поля
	3.3	Ротор и дивергенция В
4		6
	4.1	Электрический диполь
		4.1.1 Потенциал поля диполя 6
		4.1.2 Напряженность поля диполя 6
		4.1.3 Сила действующая на диполь
		4.1.4 Момент сил действующих на диполь
		4.1.5 Энергия диполя в поле
	4.2	Магнитный диполь
		4.2.1 Сила действующая на контур
		4.2.2 Момент сил
5		8
	5.1	Свободные электрические колебания
		5.1.1 Свободные незатухающие колебания
		5.1.2 Свободные затухающие колебания
		5.1.3 Апериодические режим
	5.2	Величины характеризующие затухание 9
		5.2.1 коэффициент затухания и время релаксации 9
		5.2.2 Логарифмический декремент затухания
		5.2.3 Добротность
	5.3	Вынужденные электрические колебания
		5.3.1 Векторная диаграмма
		5.3.2 Резонанс
6		11
	6.1	Условия квазистационарности
	6.2	Комплексные сопротивления
		6.2.1 Резистор
		6.2.2 Конденсатор

		6.2.3	Катушка индуктивности	1		
7			1	2		
	7.1	Прави		$\frac{1}{2}$		
	7.2	-	·	2		
	7.3			2		
		7.3.1		2		
	7.4			2		
	7.5			3		
8			1	.3		
G	8.1	Элект		. 3		
		8.1.1	L 1	13		
		8.1.2		4		
		8.1.3	1	4		
		8.1.4	1	4		
	8.2	-		15		
	0.2	8.2.1		15		
		8.2.2		15		
		8.2.3	1	L5		
		8.2.4		16		
		8.2.5		16		
		8.2.6	1 0	16		
			11	10 17		
		8.2.7	Гистерезис	- 1		
9				7		
	9.1	Разлох	J I	17		
		9.1.1	1	18		
		9.1.2	Амплитудно-модулированный сигнал 1	8		
		9.1.3	Частотно-модулированный сигнал	8		
		9.1.4	Фильтры RC, CR, RL, LR	19		
	9.2	Фильт	p RLC	9		
10			1	.9		
		Шири		20		
		.2 Спектр одиночного импульса				
		В Спектр конечного пакета колебаний				
			•	20 21		
			•	21		
	10.5	дооро	пость в спектральном представлении	, I		
11		~		21		
			V I	21		
	11.2		·	22		
				22		
	11.3	Скин-	эффект	22		

1

1.1 Закон Кулона, напряжённость

$$F = \frac{|q_1||q_2|}{r_{12}^2} \qquad \vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}$$

где $k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9\cdot 10^9\,\Phi/{\rm M}$ и $\varepsilon_0=8,85\cdot 10^{-12}\,\Phi/{\rm M}.$

Напряжённость \vec{E} - сила действующая на единичный положительный неподвижный заряд.

1.2 Поток, теорема Гаусса

$$\Phi = \int\limits_{S} \vec{E} \vec{dS} \qquad \oint \vec{E} \vec{dS} = \frac{1}{\varepsilon_0} q_{\text{внутр}}$$

- Плоскость: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0 \varepsilon}$
- Стена ширины d: $E= \left\{ egin{array}{ll} rac{
 ho x}{arepsilon_0} &, x < rac{d}{2} \\ rac{
 ho d}{2arepsilon_0} &, x \geq rac{d}{2} \end{array}
 ight.$
- Цилиндр: $E = egin{cases} rac{
 ho r}{2 arepsilon_0} &, r < R \\ rac{\sigma R}{arepsilon_0 r} &, r > R \end{cases}$
- IIIap: $E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} & , r < R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & , r > R \end{cases}$

1.3 Циркуляция и дивергенция Е

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \oint \vec{E} \vec{dl} = 0$$

1.4 Энергия электрического поля

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 SU^2}{2h} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{2} (\frac{U}{h})^2 Sh = \frac{ED}{2} V$$
$$w = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\vec{E}\vec{D}}{2} \qquad W = \int w dV$$

2

2.1 Потенциал

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \, d\vec{l}$$

Потенциал - величина, численно равная потенциальной энергии единичного положительного заряда в данной точке.

$$-d\varphi = \vec{E}\vec{dl} \qquad \vec{E} = -\nabla\varphi$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho dV}{r}$$

2.2 Уравнения Пуассона и Лапласа

$$\triangle = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2}{\partial^2 z}$$
$$\triangle \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

В Лапласе правая часть равна 0.

Определение потенциала сводится к нахождению функции φ , удовлетворяющей этим уравнениям во всём пространстве (Лаплас между проводниками, и заданные значения на поверхности самих проводников).

2.3 Проводимость, обобщённый закон Ома

$$I = \frac{U}{R} \qquad R = \rho \frac{l}{S}$$

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = \lambda \vec{E}$$

 λ - удельная электропроводность, сименс на метр (См/м).

При наличии сторонних (некулоновских) сил (\vec{E}^*) , обобщённый закон Ома:

$$\vec{j} = \lambda(\vec{E} + \vec{E}^*)$$

$$I \int_1^2 \rho \frac{dl}{S} = \int_1^2 \frac{\vec{j} dl}{\lambda} = \int_1^2 \vec{E} dl + \int_1^2 \vec{E}^* dl$$

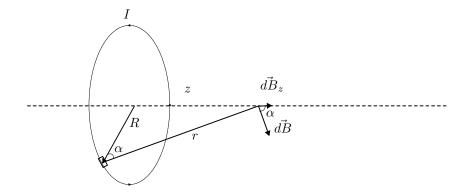
$$RI = \varphi_1 - \varphi_2 + \varepsilon_{12}$$

 $arepsilon_{12}$ - электродвижущая сила

3

3.1 Био-Савар, виток с током

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[\vec{dl} \times \vec{r}]}{r^3}$$



$$dB_z = dB \cos \alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \cos \alpha}{r^2} \qquad \cos \alpha = \frac{R}{r} \qquad r^2 = z^2 + R^2$$
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

3.2 Циркуляция магнитного поля

$$\oint \vec{B}\vec{dl} = \mu_0 I = \mu_0 \int \vec{j}\vec{dS}$$

Циркуляция вектора \vec{B} по произвольному контуру Γ равна произведению μ_0 на алгебраическую сумму токов, охватываемых контуром Γ .

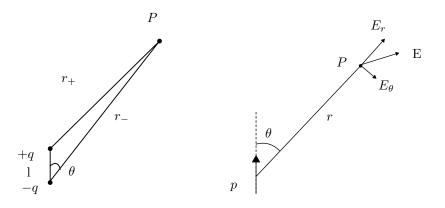
- Прямой провод: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \ r \geq R$
- Внутри длинного соленоида: $B = \mu_0 \mu n I$, где n кол-во витков на метр
- Плоскость с током: $B=\frac{\mu_0 l}{2},$ где 1 сторона контура, параллельная плоскости

3.3 Ротор и дивергенция В

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

4

4.1 Электрический диполь



Момент диполя:

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

где \vec{l} направлен от - к +, q - положительный заряд

4.1.1 Потенциал поля диполя

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2}$$

где θ - угол между р и г

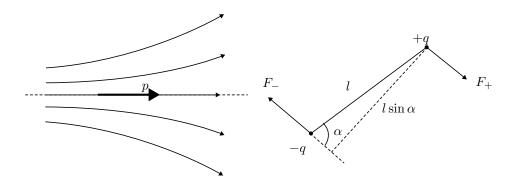
4.1.2 Напряженность поля диполя

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2p\cos\theta}{r^3} \qquad E_\theta = -\frac{\partial \varphi}{r\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\sin\theta}{r^3}$$
$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2\theta}$$

В частности при $\theta=0$ и $\theta=\frac{\pi}{2}$

$$E_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2p}{r^3} \qquad E_{\perp} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p}{r^3}$$

4.1.3 Сила действующая на диполь



$$\vec{F} = q(\vec{E_+} - \vec{E_-}) = p \frac{\partial \vec{E}}{\partial \vec{l}}$$

4.1.4 Момент сил действующих на диполь

$$M = qEl\sin\alpha = pE\sin\alpha$$
$$\vec{M} = [\vec{p} \times \vec{E}]$$

4.1.5 Энергия диполя в поле

$$W = q(\varphi_{+} - \varphi_{-}) = q \frac{\partial \varphi}{\partial l} l = -q E_{l} l = -\vec{p} \vec{E}$$

4.2 Магнитный диполь

 $\vec{p}_m = IS\vec{n},$ где S - площать контура, \vec{n} - нормаль по правилу правого винта.

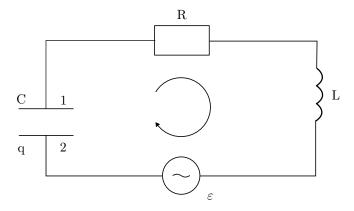
4.2.1 Сила действующая на контур

$$\begin{split} d\vec{F}_A &= I[\vec{dl} \times \vec{B}] \qquad \vec{F}_A = l[\vec{I} \times \vec{B}] \\ \vec{F} &= I \oint [\vec{dl} \times \vec{B}] \qquad \vec{F} = p_m \frac{\partial \vec{B}}{\partial \vec{n}} \end{split}$$

где p_m - модуль момента, $\frac{\partial \vec{B}}{\partial \vec{n}}$ - производная по направлению нормали $\vec{n}.$

4.2.2 Момент сил

$$\vec{M} = \oint [\vec{r} \times d\vec{F}] \qquad \vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$$



$$RI = \varphi_1 - \varphi_2 + \varepsilon_s + \varepsilon \qquad \varepsilon_s = -L\frac{dI}{dt} \qquad \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{q}{C}$$

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{c}q = \varepsilon \qquad \ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{\varepsilon}{L}$$

$$2\beta = \frac{R}{L}, \qquad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

5.1 Свободные электрические колебания

5.1.1Свободные незатухающие колебания

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \qquad q = q_m \cos(\omega_0 t)$$

Период (формула Томпсона)

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

Свободные затухающие колебания

$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = 0 \qquad q = q_m e^{-\beta t} \cos(\omega t)$$
$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Напряжение на конденсаторе и ток в контуре

$$U_C = \frac{q}{C} = \frac{q_m}{C} e^{-\beta t} cos(\omega t)$$
$$I = \omega q_m e^{-\beta t} cos(\omega t + \delta)$$

$$r = \omega q_m e^{-\beta} \cos(\omega t + \theta)$$
 $\cos \delta = -\frac{\beta}{2} \sin \delta = \frac{\omega}{2}$

5.1.3 Апериодические режим

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

При $B^2 \geq \omega_0^2$ срыв:

$$\omega_0 = \beta \qquad \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{R}{2L}$$

$$R_{\rm kp} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

5.2 Величины характеризующие затухание

5.2.1 коэффициент затухания и время релаксации

время релаксации au - время за которое амплитуда колебаний уменьшается в е раз

$$\tau = \frac{1}{\beta}$$

5.2.2 Логарифмический декремент затухания

Определяется как натуральный логарифм отношения двух значений амплитуд взятых через период колебания ${\bf T}$

$$\lambda = \ln \frac{\alpha(t)}{\alpha(t+T)} = \beta T$$

если затухание мало

$$\lambda \approx \beta \frac{2\pi}{\omega_0} = \pi R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

5.2.3 Добротность

- По определению: $Q = \frac{\pi}{\lambda}$
- При слабом затухании: $Q \approx \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$
- Энергетический смысл: $Q \approx 2\pi \frac{W}{\delta W}, \, \delta W$ уменьшение энерегии за период

5.3 Вынужденные электрические колебания

$$L\frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = \varepsilon_m cos(\omega t)$$

или

$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{\varepsilon_m}{L} cos(\omega t) \qquad q = q_m cos(\omega t - \psi)$$

где q_m - амплитуда заряда на конденсаторе, ψ - разность фаз между колебаниями заряда и внешней э.д.с ε

$$I = I_m cos(\omega t - \varphi)$$

где I_m амплитуда тока φ сдвиг по фазе между током и внешней э.д.с ε

$$I_m = \omega q_m, \qquad \varphi = \psi - \frac{\pi}{2}$$

напряжения на индуктивности сопротивлении и емкости

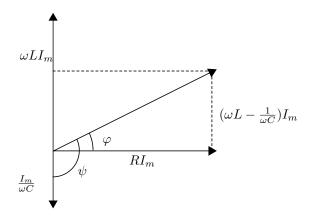
$$U_R = RI_m cos(\omega t - \varphi)$$

$$I_m = \pi$$

$$U_C = \frac{I_m}{\omega C} cos(\omega t - \varphi - \frac{\pi}{2})$$

$$U_L = I_m \omega L cos(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2})$$

5.3.1 Векторная диаграмма



$$I_m = \frac{\varepsilon_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \qquad \tan \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

учитывая что $q_m = I_m/\omega$

$$q_m = \frac{\varepsilon/L}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2) + 4\beta^2 \omega^2}}$$

5.3.2 Резонанс

$$\omega_{Ipe3} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
 $\omega_{qpe3} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$

если $\beta << \omega_0$

$$\frac{U_{Cpe3}}{\varepsilon_m} = Q \qquad Q = \frac{\omega_0}{\delta\omega}$$

где ω_0 - резонансная частота, $\delta\omega$ - ширина резонансной кривой на высоте $1/\sqrt{2}$ от максимальной

6

6.1 Условия квазистационарности

Квазистационарность - мгновенные значения тока практически одинаковы на всех участках цепи.

$$\tau = \frac{\varepsilon_0}{\lambda} << T$$

где λ - проводимость, τ - характерное время растекания, а T - характерное время изменений

$$l_{\text{хар} < < \lambda_{\text{волны}}} = \frac{c}{\nu}$$

См. векторная диаграмма

6.2 Комплексные сопротивления

6.2.1 Резистор

$$Z_R = R$$

6.2.2 Конденсатор

$$\begin{split} I &= C \frac{dU}{dt} \\ U &= U_0 e^{i(\omega t + \varphi_U)} \qquad I = i\omega C U_0 e^{i(\omega t + \varphi_U)} \\ Z_C &= \frac{U}{I} = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C} \end{split}$$

6.2.3 Катушка индуктивности

$$U = -\varepsilon_s = L \frac{dI}{dt}$$

$$I = I_0 e^{i(\omega t + \varphi_I)} \qquad U = Li\omega I_0 e^{i(\omega t + \varphi_I)}$$

$$Z_L = \frac{U}{I} = i\omega L$$

7

7.1 Правило Ленца

Индукционный ток направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей.

7.2 Закон Фарадея

$$\varepsilon = \oint \vec{E} \vec{dl} = -\frac{d\Phi}{dt} \qquad \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

При нескольких витках $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$

В полном виде:

$$\oint \vec{E} \vec{dl} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \oint [\vec{v} \times \vec{B}] \vec{dl}$$

Первое слагаемое связано с изменением магнитного поля во времени, второе - с движением контура (на эелктроны действует сила Лоренца $\vec{F}=-e[\vec{v}\times\vec{B}]$, которой соответствует $E^*=[\vec{v}\times\vec{B}]$, циркуляция даёт эдс).

7.3 Самоиндукция

$$\Phi = LI$$

L - индуктивность

$$\varepsilon_s = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{d}{dt}(LI) = -L\frac{dI}{dt}$$

7.3.1 Индуктивность катушки

Поле внутри (бесконечной) катушки (п - витки/метр):

$$dB = \mu n dh \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \qquad B = \int_{-\inf}^{\inf} dB = \mu \mu_0 n I$$

$$L = \Phi / I \qquad \Phi_1 = BS \qquad \Phi = n l BS = \mu \mu_0 n^2 V I$$

$$L = \mu \mu_0 n^2 V$$

7.4 Взаимная индукция

Два неподвижных контура достаточно близких к друг другу:

$$\Phi_2 = L_{21} \cdot I_1 \qquad \Phi_1 = L_{12} \cdot I_2$$

Где $L_{12} = L_{21} = M$ - взаимная индуктивность, при отсутствии поблизости ферромагнетиков. (Может быть и отрицательна, в отличие от L.)

7.5 Энергия магнитного поля

Работа совершаемая сторонними силами против эдс самоиндукции:

$$\varepsilon_0 = RI - \varepsilon_s \mid \cdot Idt \Rightarrow \delta A_{\text{ctop}} = \delta Q + Id\Phi$$

$$\delta A^{\text{goil}} = Id\Phi$$

Считаем что ферромагнетиков нет:

$$d\Phi = LdI \implies A^{\text{Hoff}} = \frac{LI^2}{2}$$

$$W = \frac{LI^2}{2} = \frac{I\Phi}{2} = \frac{\Phi^2}{2L}$$

$$L = \mu\mu_0 n^2 V \qquad nI = H = B/\mu\mu_0$$

$$W = \int \frac{\vec{B}\vec{H}}{2}dV \qquad w = \frac{\vec{B}\vec{H}}{2} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$$

$$L = \frac{1}{I^2} \int \frac{B^2}{\mu\mu_0}dV$$

8

8.1 Электрическое поле в веществе

Связанные заряды и их поле помечаются штрихом $(q', \rho', \sigma', \vec{E}')$, сторонне поле обозначено как \vec{E}_0 .

Под действием внешнего поля положительные и отрицательные заряды смещаются в пределах нейтральных молекул, в следствие чего возникают нескомпенсированные поверхностные заряды и соответвующий им дипольный момент.

8.1.1 Поляризованность Р

- дипольный момент объёма вещества.

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum \vec{p_i} \qquad \vec{P} = \eta \langle \vec{p} \rangle$$

Для изотропного диэлектрика:

$$\vec{P} = \kappa \varepsilon_0 \vec{E}$$

где $\kappa = \varepsilon - 1$ - диэлектрическая восприимчивость.

$$\oint \vec{P} \vec{dS} = -q'_{\text{\tiny BHYTP}} \qquad \nabla \cdot \vec{P} = -\rho'$$

Граничное условие:

$$P_{2n} - P_{1n} = -\sigma'$$

где индекс п означает проекцию на нормаль

8.1.2 Вектор D

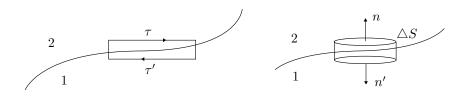
- электрическое смещение (индукция)

$$ec{D} = arepsilon_0 ec{E} + ec{P} \qquad ec{D} = arepsilon arepsilon_0 ec{E}$$

$$\oint ec{D} ec{dS} = q_{ ext{BHyTp}}^{ ext{cropohhue}}$$

 $\varepsilon=1+\kappa$ - диэлектрическая проницаемость

8.1.3 Условия на границе



Два диэлектрика

$$\begin{split} \oint \vec{E} \vec{dl} &= 0 \qquad \oint \vec{D} \vec{dS} = q_{\text{внутр}} \\ E_{1\tau} &= E_{2\tau} \qquad D_{2n} - D_{1n} = \sigma = 0 \\ \frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} &= \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \end{split}$$

Проводник - диэлектрик:

$$D_n = \sigma$$
 $E_n = (\sigma + \sigma')/\varepsilon_0 = D_n/\varepsilon\varepsilon_0$
$$\sigma' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon}\sigma$$

8.1.4 Поле в однородном диэлектрике

$$\vec{E} = rac{\vec{E}_0}{arepsilon} \qquad \vec{D} = \vec{D}_0 \qquad \vec{E}' = -\vec{P}/arepsilon_0$$

8.2 Магнитное поле в веществе

В веществе, молекулы которого имеют дипольный момент, под действием внешнего поля эти элементарные моменты приобретают пеимущественную ориентацию, суммарные магнитный момент становится отличен от нуля, магнитные поля отдельных молекул перестают компенсировать друг друга. В веществе, молекулы которого не имеют дипольного момента, внешнее поле индуцирует элементарные круговые токи в молекулах, в следствие чего образуется магнитный момент.

8.2.1 Намагниченность Ј

- магнитный момент единицы объёма

$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum \vec{p}_m \qquad \vec{J} = n \langle \vec{p}_m \rangle$$

У соседних молекул молекулярные токи в местах их соприкосновения текут в противоположных направлениях и макроскопически взаимно компенсируют друг друга. Некомпенсированными остаются только те молекулярные токи, которые выходят на боковую поверхность цилиндра. Эти токи образуют макроскопический поверхностный ток намагничивания I'.

$$\oint \vec{J} \vec{dl} = I' \qquad I' = \int \vec{j}' \vec{dS}$$

где I' - алгебраическая сумма токов намагничивания в контуре, а \vec{j}' - объёмная плотность тока намагничивания, интегрирование по произвольной поверхности, натянутой на контур.

$$abla imes \vec{J} = \vec{j}'$$

8.2.2 Вектор Н

$$\oint \vec{B} \vec{dl} = \mu_0 (I + I')$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \qquad \oint \vec{H} \vec{dl} = I$$

где I - алгебраическая сумма токов проводимости, охватываемых контуром

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{i}$$

где \vec{j} - плотность тока проводимости

8.2.3 Связь Ј и Н

$$\vec{J} = \gamma \vec{H}$$

 χ - магнитная восприимчивость

- пармагнетики $\chi > 0, \ \vec{J} \uparrow \uparrow \vec{H}$
- диамагнетики $\chi>0,\ \vec{J}\uparrow\downarrow\vec{H}$
- \bullet ферромагнетики, J зависит от предыистории (гистерезис)

8.2.4 Связь В и Н

$$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H} \qquad \mu = 1 + \chi$$

8.2.5 Граничные условия В и Н

$$\oint \vec{B} \vec{dS} = 0 \qquad \oint \vec{H} \vec{dl} = I$$

$$B_{2n} \Delta S + B_{1n} \Delta S = 0 \qquad B_{2n} = B_{1n}$$

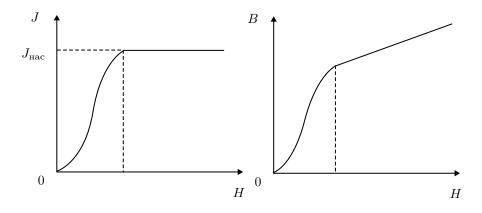
$$H_{2\tau} l + H_{2\tau} l = i_N l \qquad H_{2\tau} - H_{1\tau} = i_N$$

 \vec{N} - нормаль к контуру, i - плотность токов проводимости

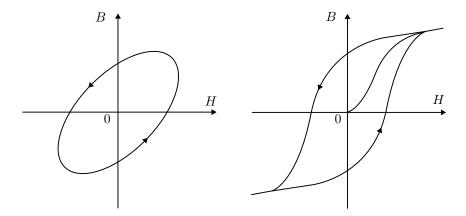
$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

8.2.6 Ферромагнетики

- вещества, которые могут обладать намагниченность при отсутствии внешнего магнитного поля. В их кристаллах могут возникать обменные силы, которые заставляют магнитные моменты электронов устанавливаться параллельно друг другу. В результате возникают области (размером 1-10 мкм) спонтанного намагничения - домены. В пределах каждого домена ферромагнетик намагничен до насыщения и имеет определенный магнитный момент. Под действием внешнего поля домены ориентированные по нему растут, в слабых полях это обратимый процесс, в сильных - необратимый. Для ферромагнетиков μ вводится как функция H.



8.2.7 Гистерезис



Гистерезис - связь между B и H определяется предшествующей историей намагничивания ферромагнетика. Линейный гистерезис наблюдается при слабых полях и высоких частотах, нелинейный - при сильных полях и низких частотах. Значение B при H=0 называется остаточной намагниченностью, значение H_c при котором B обращается в нуль называется коэрцитивной силой. Для размагничивания образец помещают в катушку, по которой пропускают переменный ток и амплитуду его постепенно уменьшают до нуля.

Объёмная плотность потеранной энергии определяется площадью заключённой внутри петли.

$$w = \pi H_0 B_0 \sin \varphi = \pi H_0 B_1$$

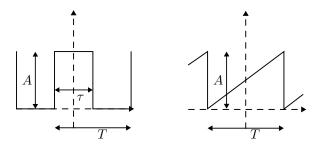
9

9.1 Разложение Фурье

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\inf} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$
$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t)\cos(n\omega t)dt \qquad b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t)\sin(n\omega t)dt$$

В чётной функции $b_n=0$, в нечётной $a_n=0$.

9.1.1 Основные разложения



(Это лучше перепроверить посчитав ручками)

- Прямоугольник : $\frac{4A}{\pi} \left[\sum \frac{\sin(n\pi\tau/T)}{n} \cos(n\omega t) \right]$
- Пила: $\frac{A}{2} + \sum \frac{A}{\pi n} (-1)^{n+1} \sin(n\omega t)$
- Двухполупериодное выпрямление (модуль косинуса): $A[\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}[\frac{\cos(2\omega t)}{1\cdot 2}]+\frac{\cos(4\omega t)}{3\cdot 5}+...]$

9.1.2 Амплитудно-модулированный сигнал

$$U = U_0[1 + m\cos(\omega t)]\cos(\omega_0 t)$$

где $U_0,\ \omega_0$ - амплитуда и частота модулируемого (несущего) сигнала, ω - частота модулирующего (информационного) сигнала, $m\leq 1$ - коэффициент модуляции

$$U = U_0[\cos(\omega_0 t) + \frac{m}{2}\cos(\omega_0 - \omega) + \frac{m}{2}\cos(\omega_0 + \omega)]$$

Следовательно на спектре получаем 3 гармоники: несущего колебания и двух боковых полос.

9.1.3 Частотно-модулированный сигнал

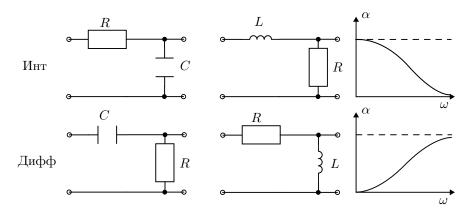
$$U = U_0 \cos(\omega_0 t + m \cos(\omega t))$$

$$U = U_0 \cos(\omega_0 t) \cos(m \cos(\omega t)) - U_0 \sin(\omega_0 t) \sin(m \cos(\omega t))$$

При малом m, имеем $\cos(m\cos(\omega t)) \approx 1$, $\sin(m\cos(\omega t)) \approx m\cos(\omega t)$

$$U = U_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{mU_0}{2} \cos[(\omega_0 - \omega)t + \frac{\pi}{2}] + \frac{mU_0}{2} \cos[(\omega_0 + \omega)t + \frac{\pi}{2}]$$

9.1.4 Фильтры RC, CR, RL, LR



Коэффициент передачи α (всегда ≤ 1):

$$\alpha = |\frac{U_{\text{bmx}}}{U_{\text{bx}}}|$$

Интегрирующая цепочка пропускает низкие частоты, дифференцирующая - высокие.

• Mht RC:
$$U_{\text{bx}}=IR+I\frac{1}{i\omega C},\,U_{\text{bhix}}=I\frac{1}{i\omega C},\,\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+(R\omega C)^2}}$$

• Диф RC:
$$U_{\text{bx}}=IR+I\frac{1}{i\omega C},\,U_{\text{вых}}=IR,\,\alpha=\frac{R\omega C}{\sqrt{1+(R\omega C)^2}}$$

• Mht RL:
$$U_{\text{bx}}=IR+Ii\omega L,\,U_{\text{bhix}}=IR,\,\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\omega L}{R})^2}}$$

• Диф RL:
$$U_{\text{вх}}=IR+Ii\omega L,\,U_{\text{вых}}=Ii\omega L,\,\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{R}{\omega L})^2}}$$

Полоса пропускания - полоса частот, в пределах которой $\alpha \geq 1/\sqrt{2}$. (мощность $\geq 1/2$)

Для RC и LC цепочек вводится понятие частоты среза соответсвующей границе полосы пропускания. RC: $\nu_{\rm cp}=\frac{1}{2\pi RC},$ RL: $\nu_{\rm cp}=\frac{R}{2\pi L}$

9.2 Фильтр RLC

Резонанс в колебательном в колебательном контуре может быть использован для усиления или подавления определённой части частотного спектра. (см резонанс)

10

Период функции стремится к бесконечности $T \to \inf$, дискретный набор частот переходит в непрерывный $n\Omega \to \omega$, расстояние между соседними

спектральными линиями стремится к нулю $(n+1)\Omega - n\Omega = \Omega = 2\pi/T \to 0$, сумма по гармоникам переходит в интеграл Фурье:

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} e^{in\Omega t} C_n \to \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$
$$\rho(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

10.1 Ширина спектра

- область частот, в пределах которой заключена основная часть (90%) энергии сигнала.

Из соотношения неопределённости:

$$\Delta p \Delta x \sim h$$

$$\delta x = \tau c \qquad \Delta p = h \Delta \nu / c$$

$$\frac{h \Delta \nu}{c} \tau c \sim h \qquad \tau \Delta \nu \sim 1$$

10.2 Спектр одиночного импульса

Одиночный импульс площади S, продолижтельности τ .

$$\rho = \frac{1}{2\pi} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \frac{S}{\tau} e^{-i\omega t} dt = \frac{S}{2\pi} \frac{\sin(\frac{\omega\tau}{2})}{\frac{\omega\tau}{2}}$$

Ширину спектра можно охарактеризовать отрезком от $\omega=0$ до $\omega_1\tau/2=\pi,$ откуда $\Delta\omega\tau=\omega_1\tau=2\pi$ или $\Delta\nu\tau=1$

10.3 Спектр конечного пакета колебаний

Задан отрезок синусоиды $S_m \sin(\Omega t)$, длины τ

$$\rho = \frac{1}{2\pi} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} S_m \sin(\Omega t) e^{-i\omega t} dt = \frac{S_m}{2\pi} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \frac{e^{i\Omega t} - e^{-i\Omega t}}{2i} e^{-i\omega t} dt =$$

$$= \frac{S_m}{2\pi} \frac{1}{2i} \left[\frac{e^{i(\Omega - \omega)\tau/2} - e^{-i(\Omega - \omega)\tau/2}}{i(\Omega - \omega)} - \frac{e^{i(\Omega + \omega)\tau/2} - e^{-i(\Omega + \omega)\tau/2}}{i(\Omega + \omega)} \right] =$$

$$= \frac{S_m \tau}{4\pi i} \left[\frac{\sin(-\Omega + \omega)\tau/2}{(-\Omega + \omega)\tau/2} - \frac{\sin(\Omega + \omega)\tau/2}{(\Omega + \omega)\tau/2} \right]$$

Максимум при $\omega=\Omega$, полуширину $\Delta\omega=\omega-\Omega$ характеризуем условием $(-\Omega+\omega)\tau/2=\pi=\Delta\omega\tau/2$ или $\Delta\omega\tau=2\pi$, итого $\Delta\nu\tau=1$

10.4 Спектр затухающий сигнал

$$f(t) = ae^{-\beta t}\cos(\omega_1 t) \qquad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \qquad t \ge 0$$

$$\rho(\omega) = \frac{a}{2\pi} \int_0^\infty e^{-i\omega t} e^{-\beta t} \frac{e^{i\omega_1 t} + e^{-i\omega_1 t}}{2} dt =$$

$$= \frac{a}{4\pi} \int_0^\infty (exp[(-i\omega + i\omega_1 - \beta)t] + exp[(-i\omega - i\omega_1 - \beta)t]) dt =$$

$$= \frac{a}{4\pi} (\frac{1}{\beta + i(\omega - \omega_1)} + \frac{1}{\beta + i(\omega + \omega_1)})$$

$$|\rho(\omega)| = \frac{a}{4\pi} (\frac{1}{\sqrt{\beta^2 + (\omega - \omega_1)^2}} + \frac{1}{\sqrt{\beta^2 + (\omega + \omega_1)^2}})$$

Введём характерную щирину спектра энергии: $\Delta \omega_{1/2} = |\omega - \omega_1|$, так что

$$\frac{1}{1 + (\frac{\omega - \omega_1}{\beta})^2} = \frac{1}{2}$$

Имеем $\omega_{1/2}/\beta = \Delta\omega_{1/2}\tau = 1$

10.5 Добротность в спектральном представлении

$$Q = \frac{\omega_0}{\delta\omega}$$

где ω_0 - резонансная частота, $\delta\omega$ - ширина резонансной кривой на высоте $1/\sqrt{2}$ от максимальной

11

11.1 Система уравнений Максвелла

$$\int \vec{E} \vec{dl} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} \qquad \oint \vec{B} \vec{dS} = 0$$

$$\oint \vec{H} \vec{dl} = \int (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S} \qquad \oint \vec{D} d\vec{S} = \int \rho dV$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

Вместе с силой Лоренца $d\vec{p}/dt=q\vec{E}+q[\vec{v}\times\vec{B}]$ диф. уравнения составляют фундаментальную систему (для интегрально нен ужно)

11.2 Ток смещения

$$\oint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S} = \frac{\partial q}{\partial t} \qquad \oint \vec{j} d\vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t}$$

$$\oint (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S} = 0$$

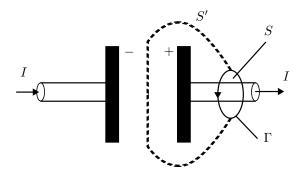
 $\vec{j}_{\rm cm} = \partial \vec{D}/\partial t$ - ток смещения, $\vec{j}_{\rm полн} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ - полный ток, его линии являются непрерывнами в отличии от линий тока проводимостки, токи проводимости замыкаются токами смещения.

$$\oint \vec{H} \vec{dl} = I_{\text{полн}} = \int (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \vec{dS}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Ток смещения эквивалентен току проводимости только в отношении способности создавать магнитное поле. Ток смещения существует только там, где меняется со временем электрическое поле.

11.2.1 Ток смещения в конденсаторе



Циркуляция вектора H не должна зависить от выбора натянутой на контур поверхности. Но если учитывать только токи проводимости это условие не выполняется?! Дальше см. прошлый пункт.

11.3 Скин-эффект

В общем виде диффузионный процесс описывается следующими уравнениями:

$$\frac{\partial j}{\partial x} = -\frac{\partial n}{\partial t} \qquad j = -D\frac{\partial n}{\partial x}$$

где n - концентрация, D - диффузионный коэффициент. Считая что концентрация равна 0 во всех точка правее l: $j\sim Dn/l$, в то же время j=nv, где v - скорость распространения, сдеовательно $v\sim D/l$, время диффундирования на расстояние l: $\tau\approx l/v\approx l^2/D$

$$l \sim \sqrt{D\tau}$$

Переходя к проникновению электромагнитного поля в металл:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial D_e}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Для проводников в первом уравнении $j>>\partial D_e/\partial t,$ в силу высокой проводимости, пренебрегаем вторым слогаемым.

$$\vec{j} = \lambda \vec{E} \qquad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

$$\vec{j} = \frac{1}{\mu_0 \mu} \nabla \times \vec{B} \qquad \nabla \times \vec{j} = -\lambda \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Полагая, что ток течёт по оси Y, магнитное поле направлено вдоль оси \mathbf{Z} , и все величины зависят только от x:

$$\frac{\partial j}{\partial x} = -\lambda \dot{B}$$
 $j = -\frac{1}{\mu_0 \mu \lambda} \frac{\partial}{\partial x} (\lambda B)$

Проводя замену $n \to \lambda/c$ и полагая $D = \frac{1}{\mu_0 \mu \lambda}$, ток меняется своё направление за T/2 тогда толщина скин-слоя:

$$l \approx \sqrt{D\frac{T}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\mu_0 \mu \lambda \nu}}$$